(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-160859 (P2003-160859A)

(43)公開日 平成15年6月6日(2003.6.6)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I			テーマコード(参考)
C 2 3 C	14/34		C 2 3 C 14	4/34	Α	4 K 0 2 9
C 2 2 C	5/06		C 2 2 C 5	5/06	Z	5D029
G 1 1 B	7/24	5 3 8	G11B 7	7/24	538E	5 D 1 2 1
	7/26	5 3 1	7	7/26	5 3 1	

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号	特願2001-358852(P2001-358852)	(71)出願人 000006264
		三菱マテリアル株式会社
(22)出願日	平成13年11月26日(2001.11.26)	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
		(72)発明者 森 曉
		兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マ
		テリアル株式会社三田工場内
		(74)代理人 100076679
		弁理士 富田 和夫 (外1名)
		Fターム(参考) 4KO29 BA22 BC07 BD00 BD09 CA05
		DC04 DC08
		5D029 MA13
		5D121 AA05 EE03 EE09 EE14

(54) 【発明の名称】 光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲット

(57)【要約】

【課題】 光記録ディスク(CD-RW, DVD-RAM)などの光記録媒体の反射膜を形成するための銀合金スパッタリングターゲットを提供する。

【解決手段】I nおよびSnの内の1種または2種を合計で0.5~15質量%を含み、さらにCr,Со,Niの内の1種または2種以上を合計で0.01~5質量%を含み、残部がAgである組成の銀合金からなる光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲット、およびそのターゲットをスパッタリングすることにより形成された経時変化の少ない光記録媒体の反射膜。

20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】I nおよびSnの内の1種または2種を合計で0.5~15質量%を含み、さらにCr, Co, Niの内の1種または2種以上を合計で0.01~5質量%を含み、残部がAgである組成の銀合金からなることを特徴とする光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲット。

【請求項2】請求項1記載のターゲットをスパッタリングすることにより形成された経時変化の少ない光記録媒体の反射膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光記録ディスク (CD-RW, DVD-RAM) などの光記録媒体の反 射膜を形成するための銀合金スパッタリングターゲット に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、光記録ディスク(CD-RW, D VD-RAM) などの光記録媒体の反射膜としてAg反 射膜が使用されており、このAg反射膜は400~83 0 nmの幅広い波長域での反射率が高く、特に他の金属 の反射膜にくらべて、青色レーザー光などの短波長のレ ーザー光に対する反射率が優れているところから広く使 用されている。しかし、記録媒体が書き換え可能な相変 化形タイプの場合は、反射膜は記録媒体の線速に応じて 熱伝導率を容易に制御できることが必要であるが、Ag 反射膜は熱伝導率が良すぎるという欠点がある。したが って反射率が高くかつ熱伝導率の低い反射膜が求められ ており、その反射率が高くかつ熱伝導率の低い反射膜の 例としてAgにCu, Mg, Zn, Sn, Bi, In, Ti、Zr、Au、Pd、Ptのうちの1種以上を含む Ag合金からなる反射膜が知られており(特開2001 -35014号公報参照)、さらにAg-In, Ag-V、Ag-Nbなどの合金からなる反射膜が知られてい る(特開平6-243509号公報参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これら従来の Ag合金反射膜は、いずれも表面の耐候性が不十分であるところから、時間が経つにつれて反射率が低下し、特 に波長の短い青色レーザー光に対する反射率の低下が著 40 しく、短期間に光記録媒体の反射膜としての性能が低下 するという問題点があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】そこで本発明者らは、経時変化の少ないAg合金反射膜を得るべく研究を行なっていたところ、(イ)In:0.5~15質量%を含み、さらにCr,Co,Niの内の1種または2種以上を合計で0.01~5質量%を含み、残部がAgである組成の銀合金からなるターゲットを用いてスパッタリングすることにより得られた銀合金反射膜は、経時変化に50

よる反射率の低下が極めて少なくなる、(ロ)Agに含まれるSnはInと同じ作用を有するので、(イ)における銀合金に含まれるInの一部または全部をSnで置換することもできる、という研究結果が得られたのであ

【0005】この発明は、かかる研究結果に基づいて成されたものであって、(1)InおよびSnの内の1種または2種を合計で0.5~15質量%を含み、さらにCr,Co,Niの内の1種または2種以上を合計で0.01~5質量%を含み、残部がAgである組成の銀合金からなる光記録媒体の反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲット、(2)前記(1)記載のターゲットをスパッタリングすることにより形成された経時変化の少ない光記録媒体の反射膜、に特徴を有するものである。

【0006】この発明の銀合金反射膜を形成するためのスパッタリングターゲットは、高純度Agを真空または不活性ガス雰囲気中で溶解し、得られた溶湯にInおよび/またはSnを添加してAg合金溶湯を作製し、このAg合金溶湯に、予め作製しておいたCrーAg母合金、CoーAg母合金、NiーAg母合金を添加して所定の成分組成のAg合金となるように真空または不活性ガス雰囲気中で溶解し、このようにして得られた溶湯を真空または不活性ガス雰囲気中で鋳造してインゴットを作製し、得られたインゴットを熱間加工したのち機械加工することにより製造することができる。

【0007】次に、この発明のAg合金からなるスパッタリングターゲットおよびこのターゲットを用いて形成したAg合金反射膜の成分組成を前記の如く限定した理由を説明する。

【0008】In, Sn:これら成分は、Ag合金反射膜の反射率が経時変化するのを防止する効果があるが、これら成分が0.5質量%未満含んでも十分な耐候性が得られず、一方、15質量%を越えて含有すると、Ag合金反射膜の初期反射率が低下するようになるので好ましくない。したがって、Ag合金反射膜およびこのAg合金反射膜を形成するためのスパッタリングターゲットに含まれるこれら成分の含有量は0.5~15質量%(一層好ましくは5~10質量%)に定めた。

【0009】Cr、Co、Ni:これら成分は、InおよびSnの内の1種または2種を合計で0.5~15質量%を含むAg合金反射膜の耐候性を一層強化して反射率が経時変化するのを防止する成分であるが、これら成分の1種または2種以上を合計で0.01質量%未満含んでも一層の耐候性が得られず、一方、これら成分の1種または2種以上を合計で5質量%を越えて含有すると、耐候性は一層優れたものとなるものの、Ag合金反射膜の初期反射率が低下するようになるので好ましくない。したがって、Ag合金反射膜およびこのAg合金反射膜を形成するためのスパッタリングターゲットに含まれる

3

これら成分の含有量は0.01~5質量%(一層好ましく は0.5~3質量%)に定めた。

[0010]

【発明の実施の形態】原料として、Ag、In、Snを Ar雰囲気にて高周波誘導加熱炉により溶解し、得られ た溶湯に予めプラズマアーク溶解炉を使用して作製して おいたCr-Ag母合金、Co-Ag母合金、Ni-A g母合金を添加してAg合金溶湯を作製し、これらAg 合金溶湯をAr雰囲気中で鋳造することにより直径:1 00mm、長さ:90mmの寸法を有するインゴットを 10 0.5Paになるまで入れ、直流電力:100Wの条件 作製した。このインゴットを輪切り状に切断して直径: 100mm、厚さ:30mmの寸法を有する円板を作製 し、さらにこの円板を600℃にて熱間圧延することに より厚さ:6mmの寸法を有する圧延板を作製し、これ を機械加工することにより直径:200mm、厚さ:5 mmの寸法を有し表1~2に示される成分組成を有する 本発明銀合金スパッタリングターゲット(以下、本発明 ターゲットという) 1~23、比較銀合金スパッタリン グターゲット(以下、比較ターゲットという)1~6お よび従来銀合金スパッタリングターゲット(以下、従来 20 ターゲットという)を作製した。

*【0011】この様にして得られた本発明ターゲット1 ~23、比較ターゲット1~6および従来ターゲットを それぞれ厚さ:10mmの無酸素銅製冷却板にIn-S n共晶はんだを用いてはんだ付けしたのち、通常の直流 マグネトロンスパッタリング装置に取り付け、さらに直 径:120mm、厚さ:1.2mmの寸法を有するポリ カーボネート樹脂板をターゲットと基板の距離が7cm となるようにセットし、チャンバー内を1×10⁻⁴Pa まで真空に引いた後、アルゴンガスをチャンバー内に で40秒間スパッタリングし、膜厚:100nmの反射 膜を形成した。

【0012】これら反射膜に、波長が405nmおよび 650 nmのレーザー光を照射してエリプソメータによ り反射率を測定し、その後反射膜を恒温恒湿槽容器(80 ℃、85%)に200時間保持した後、同様にして波長が 405nmおよび650nmのレーザー光を照射してエ リプソメータにより反射率を測定し、その結果を表1~ 2に示すことにより反射膜の耐候性を評価した。

【0013】

【表1】

									· -		
種別				成分組	成 (質 量	(%)		波長:405nmのレーザー光照 射による反射膜の反射率(%)		被長:650nmのレーザー光照 射による反射膜の反射率(%)	
		Ιn	Sn	Сr	Со	Νi	A g	成膜直後	200 時間経過後	成膜直後	200時間経過後
	1	0.5	-	2	-		残部	90	85	95	89
	2	3	-		3		残部	92	80	98	87
	3	7	-	-	-	1	残部	89	80	95	90
	4	10	-	0.1	-	-	残部	83	79	94	89
۱	5	15	-	-	0.1	-	残部	85	78	98	87
本発	6	-	0.5	4	-	-	残部	91	79	97	86
明	7		3		3		残部	92	80	97	92
ター	8	-	7	-	-	2	残部	90	81	96	88
ゲ	9	-	10	1	-	-	残部	89	79	95	88
ット	10	-	15	-	-	0.5	残部	87	80	98	91
-	11	0.5	7	1	-	-	残部	85	77	95	90
	12	3	5	-	2		残部	83	78	94	87
	13	7	3		-	3	残部	90	80	93	86
	14	8	2	-	1	1	残部	90	81	95	88
	15	10	1	0.8	0.6		残部	90	80	96	90

[0014]

※ ※【表2】

種別			БŽ	分組成	克(質量:	光)		波長: 405nm のレーザー光照射 による反射膜の反射率 (%)		波長:650nm のレーザー光照 射による反射膜の反射率(%)	
		Ιn	Sn	Сг	Со	Νi	Ag	成膜直後	200時間経過後	成膜直後	200 時間経過後
	16	6	-	0.5	0.5	0.5	残部	90	79	95	89
本	17	-	7	3	1	1	残部	88	80	94	89
発明	18	-	5	-	2	1	残部	90	81	96	87
夕	19		6	0.3	-	1	残部	90	82	94	88
	20	9	-	0.3	1		残部	89	78	95	92
ゲッ	21	0.5	-	-	0.5	3	残部	88	80	94	89
۴	22	3	-	2	-	0.5	残部	90	81	95	88
	23	7	3	0.5		0.4	残部	90	80	92	89
	1	-	0.4*	-			残部	90	51	95	65
	2	0.4*	-	-	-	-	残部	91	50	97	65
比	3	-	7	.*	_*	_*	残部	85	60	94	78
較	4	7	-	.*	.*	_*	残部	85	59	95	77
	5	18*	-	1	-		残部	70	65	85	70
	6	7	-	6*	-		残部	70	65	88	79
従	来	_	-		-	-	100	90	55	98	75

^{*} 印はこの発明の範囲から外れていることを示す。

【0015】表1~2に示される結果から、この発明の うことにより得られた反射膜は、比較ターゲット1~6 および従来ターゲットを用いてスパッタリングを行うこ とにより得られた反射膜に比べて反射率の低下が少ない ところから、耐候性に優れていることがわかる。

[0016]

*【発明の効果】上述のように、この発明の光記録媒体の 本発明ターゲット 1 ~ 2 3 を用いてスパッタリングを行 20 反射膜形成用銀合金スパッタリングターゲットを用いて 作製した反射膜は、従来の光記録媒体の反射膜形成用銀 合金スパッタリングターゲットを用いて作製した反射膜 に比べて、経時変化による反射率の低下が少なく、長期に わたって使用できる光記録媒体を製造することができ、 メディア産業の発展に大いに貢献し得るものである。

PAT-NO: JP02003160859A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2003160859 A

TITLE: SILVER ALLOY SPUTTERING

TARGET FOR FORMING

REFLECTION COAT ON OPTICAL

RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: June 6, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MORI, AKIRA N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUBISHI MATERIALS CORP N/A

APPL-NO: JP2001358852

APPL-DATE: November 26, 2001

INT-CL (IPC): C23C014/34 , C22C005/06 ,

G11B007/24 , G11B007/26

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silver alloy sputtering target for forming a reflection coat on an optical recording medium such as optical recording disks (CD-RW and DVD-RAM).

SOLUTION: The silver alloy sputtering target

for forming the reflection coat on the optical recording medium comprises one or two of In and Sn in amounts of 0.5-15 mass% in total, further one or more of Cr, Co and Ni in amounts of 0.01-5 mass% in total, and the balance Ag. The reflection coat on the optical recording medium formed by sputtering the target hardly changes with time.

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO